【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第４区分
【発行日】平成17年9月8日(2005.9.8)

【公開番号】特開2003-263807(P2003-263807A)
【公開日】平成15年9月19日(2003.9.19)
【出願番号】特願2002-65286(P2002-65286)
【国際特許分類第７版】
　Ｇ１１Ｂ　11/105
【ＦＩ】
　Ｇ１１Ｂ　11/105　５４６Ａ
　Ｇ１１Ｂ　11/105　５１６Ｋ
　Ｇ１１Ｂ　11/105　５３１Ｖ
　Ｇ１１Ｂ　11/105　５４６Ｃ
　Ｇ１１Ｂ　11/105　５４６Ｇ

【手続補正書】
【提出日】平成17年3月10日(2005.3.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、少なくとも記録磁区の磁壁が移動する第１磁性層と、前記第１の磁性層及び第３の磁性層よりキュリー温度の低い第２磁性層と、周囲温度近傍の温度において第１の磁性層に比べて相対的に磁壁抗磁力が大きく、かつ垂直磁化膜からなる第３磁性層と、誘電体層と、放熱層とがこの順で積層されている磁壁移動検出方式の光磁気記録媒体のアニール処理方法であって、前記第３の磁性層の隣り合う情報記録トラックの間の領域（トラック間領域）に高出力のレーザービームを膜面側から照射した後、前記放熱層を前記誘電体層上に積層することを特徴とする光磁気記録媒体のアニール処理方法。